

NPN BU508DF

SILICON DIFFUSED POWER TRANSISTOR

The BU508DF is a NPN epitaxial-base transistor in TO3PFa package with integrated efficiency diode.

It is intended for high voltage, high-speed.

Primarily for use in horizontal deflection circuits of colour television receivers.

Compliance to RoHS.

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

Symbol	Ratings	Value	Unit
V_{CBO}	Collector-Base Voltage	1500	V
V_{CEO}	Collector-Emitter Voltage	700	V
V_{EBO}	Emitter-Base Voltage	5	V
I_C	Collector Current	8	A
I_{CM}	Collector Current Peak	15	A
I_B	Base Current	4	A
I_{BM}	Base Current Peak	6	A
P_T	Total Dissipation @ $T_{mb} < 25^\circ$	34	W
t_J	Junction Temperature	150	°C
t_s	Storage Temperature range	-65 to +150	

THERMAL CHARACTERISTICS

Symbol	Ratings	Conditions	Value		Unit
			Typ.	Max	
R_{thJC}	Junction To Heatsink	Without Heatsink Compound	-	3.7	K/W
	Junction To Heatsink	With Heatsink Compound	-	2.8	
	Junction Ambient	In Free Air	35	-	

NPN BU508DF

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

TC=25°C unless otherwise noted

Symbol	Ratings	Test Condition(s)	Min	Typ	Max	Unit
V_{CEO}	Collector-Emitter Breakdown Voltage	$I_C = 100 \text{ mA}$, $I_B = 0$ $L = 25 \text{ mH}$	700	-	-	V
I_{CES}	Collector Cutoff Current	$V_{BE} = 0$, $V_{CE} = 1500 \text{ V}$	-	-	1	mA
		$V_{BE} = 0$, $V_{CE} = 1500 \text{ V}$ $T_j = 125^\circ\text{C}$	-	-	2	
I_{EBO}	Emitter Cutoff Current	$V_{EB} = 5 \text{ V}$, $I_C = 0$	-	-	300	mA
$V_{CE(SAT)}$	Collector-Emitter saturation Voltage	$I_C = 4.5 \text{ A}$, $I_B = 1.6 \text{ A}$	-	-	1	V
$V_{BE(SAT)}$	Base-Emitter saturation Voltage	$I_C = 4.5 \text{ A}$, $I_B = 2 \text{ A}$	-	-	1.1	
V_F	Diode Forwardvoltage	$I_F = 4.5 \text{ A}$	-	1.6	2	V
h_{FE}	DC Current Gain	$I_C = 500 \text{ mA}$, $V_{CE} = 5 \text{ V}$	10	-	30	-
C_{OB}	Output Capacitance	$V_{CB} = 10 \text{ V}$, $I_E = 0$, $f = 1 \text{ MHz}$	3	-	-	A
f_T	Transition Frequency	$V_{CE} = 5 \text{ V}$, $I_C = 100 \text{ mA}$	-	7	-	MHz

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9